PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-209065

(43)Date of publication of application: 03.08.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1343 G02F 1/1335 G02F 1/139 G09F 9/30

(21)Application number: 2000-368138

(71)Applicant: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

(22)Date of filing:

04.12.2000

(72)Inventor: RA HEIZEN

PARK SEUNG BEOM

IN JOSEN

(30)Priority

Priority number: 1999 9954557

Priority date: 02.12.1999

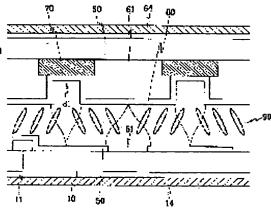
Priority country: KR

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE WITH WIDE VIEWING ANGLE AND SUBSTRATE TO BE USED FOR THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a wide viewing angle and to improve the picture quality, with respect to a liquid crystal display device.

SOLUTION: The substrate for a liquid crystal display device has a glass substrate 60, a color filter 61 which is formed on the glass substrate 60 and which has a recessed pattern with its side walls making 30° to 120° angle to the glass substrate 60, and a common electrode 80 which is formed on the color filter 61 and which has a recessed pattern 81 along the recessed pattern of the color filter 60.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

- 。 rejêction] ໊
 - i [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-209065 (P2001-209065A)

(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

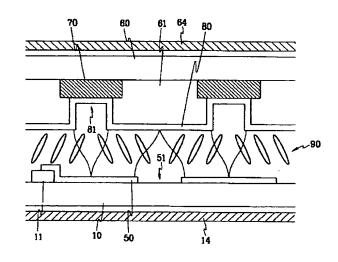
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI			テーマコード(参考)
G 0 2 F	1/1343		G 0 2 F	1/1343		
	1/1335	500		1/1335	500	
		5 0 5			505	
	1/139		G09F	9/30	3 4 9 1	3
G09F	9/30	3 4 9	G 0 2 F	1/137	505	
			審査請求	未請求	請求項の数20	OL (全 8 頁)
(21)出願番号		特願2000-368138(P2000-368138	(71)出願人	390019839		
				三星電	子株式会社	
(22)出願日		平成12年12月4日(2000.12.4)		大韓民	国京畿道水原市戸	(達区梅灘洞416
			(72)発明者	羅炳	善	
(31)優先権主張番号		1999-54557		大韓民国京畿道水原市八達区盧通洞シンナ		
(32)優先日		平成11年12月2日(1999.12.2)		ムシル住公アパート508棟1502号		
(33)優先権主張国		韓国 (KR)	(72)発明者	朴 乘	範	
				大韓民[国京畿道龍仁市器	器與邑舊葛里404-
				2ウリ.	ムアパート1007号	}
			(72)発明者	尹汝	鲜	
				大韓民	国ソウル市銅雀□	【舍洞443-5シン
				ハンピ	ラ301号	
			(74)代理人	1000941	45	
,				弁理士	小野 由己男	(外1名)

(54) 【発明の名称】 広視野角液晶表示装置及びそれに用いられる基板

(57)【要約】

【課題】液晶表示装置において、広視野角を得ることに ある。また、画質を改善することにある。

【解決手段】ガラス基板60と、ガラス基板60上に形成され、側壁がガラス基板60に対して30°~120°の角度をなす陥没パターンを有するカラーフィルター61と、カラーフィルター61上に形成され、カラーフィルター60の陥没パターンに沿って陥没パターン81を有する共通電極80とを備える液晶表示装置用基板。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板と、

前記基板の上に形成され、側壁が前記基板に対して30°以上120°以下の角度をなす陥没パターンを有するカラーフィルターと、

1

前記カラーフィルター上に形成される共通電極と、を備える液晶表示装置用基板。

【請求項2】前記基板の上に形成されているブラックマトリックスをさらに含み、

前記ブラックマトリックスの中の一部は前記陥没パターンと重畳するように形成されている、請求項1に記載の液晶表示装置用基板。

【請求項3】第1基板と、

前記第1基板の上に形成されている多数の画素電極と、 前記第1基板と対向して配置される第2基板と、

前記第2基板の上に形成され、前記画素電極に対応する 位置に、側壁が前記第1基板に対して30°以上120 。以下の角度をなす陥没パターンを有する共通電極と、 を備える液晶表示装置。

【請求項4】前記第2基板と前記共通電極との間に形成 20 されていて陥没パターンを有するカラーフィルターをさらに含み、

前記共通電極の陥没パターンは、前記カラーフィルター の陥没パターンによって形成されている、請求項3に記 載の液晶表示装置。

【請求項5】前記第2基板に形成されており、前記共通電極の陥没パターンと一部が重なるブラックマトリックスをさらに含む、請求項3又は4に記載の液晶表示装置。

【請求項6】前記共通電極の陥没パターン部分は、前記 ブラックマトリックスと接触している、請求項5に記載 の液晶表示装置。

【請求項7】前記第1基板の上に形成されている維持容 量電極をさらに含み、

前記第1基板を上から見る時、前記画素電極が前記維持容量電極を少なくとも一定の部分で完全に覆っている、 請求項3から6のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項8】前記画素電極が前記維持容量電極を完全に 覆っている一定の部分は、前記共通電極に形成されてい る陥没パターンと前記画素電極の辺が重なる部分であ る、請求項7に記載の液晶表示装置。

【請求項9】前記維持容量電極は、前記画素電極の左右に各々一つずつ位置することを特徴とする、請求項7又は8に記載の液晶表示装置。

【請求項10】前記維持容量電極は共通電極線の枝である、請求項7から9のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項11】前記共通電極線は前記陥没パターンと重なる、請求項7から10のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項12】前記画素電極は開口パターンを有する、

請求項7から11のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項13】前記画素電極の開口パターンは、前記画素電極を上下に二分する位置に横方向に形成されている 横開口部と、二分された前記画素電極の上下部分に各々 斜線方向に形成されている斜線開口部とを含み、前記上 下の斜線開口部は互いに垂直をなしており、

前記共通電極の陥没パターンは、前記開口パターンの斜線開口部を間に介在してこれと並んだ斜線部と前記画素電極の辺と重なっている屈折部を含んでいる、請求項1 2に記載の液晶表示装置。

【請求項14】前記画素電極が前記共通電極の枝電極を 完全に覆っている一定の部分は、前記陥没パターンの屈 折部が前記画素電極の縦辺と重なっている部分である、 請求項13に記載の液晶表示装置。

【請求項15】前記画素電極の開口パターンと前記共通電極の陥没パターンは重なって前記画素電極を多数の小領域に分割しており、前記小領域は最も長い二つの辺が互いに平行な多角形であることを特徴とする、請求項12に記載の液晶表示装置。

【請求項16】前記小領域は最も長い二つの辺が第1方 向である第1小領域と第2方向である第2小領域とに分 類され、前記第1方向と前記第2方向とは85°以上9 5°以下の角をなす請求項15に記載の液晶表示装置。 【請求項17】前記第1方向は、前記画素電極の辺に対 して斜線方向である、請求項16に記載の液晶表示装 置。

【請求項18】前記第1方向は、前記画素電極の上下辺または左右辺のうちのいずれか一つと平行な、請求項16に記載の液晶表示装置。

30 【請求項19】第1基板と、

前記第1基板の上に形成される維持容量電極と、 前記第1基板の上に形成される多数の画素電極と、 前記第1基板と対向して配置される第2基板と、 前記第2基板の上に形成され、前記画素電極に対応する 位置に陥没パターンを有する共通電極とを含み、 前記第1基板を上から見る時、前記画素電極が前記維持 容量電極を少なくとも一定の部分で完全に覆っている液 晶表示装置。

【請求項20】前記画素電極が前記維持容量電極を完全 40 に覆っている一定の部分は、前記共通電極に形成されて いる陥没パターンと前記画素電極の辺が重なる部分であ る、請求項19に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、広視野角液晶表示 装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に液晶表示装置は二枚の基板の間に 液晶を注入し、ここに加える電場の強さを調節して光透 50 過量を調節する構造からなっている。

【0003】垂直配向捩じれネマチック(vertically aligned twis-ted nematic; VATN)方式の液晶表示装置は、内側面に透明電極が形成されている一組の透明基板、二つの透明基板の間の液晶物質、それぞれの透明基板の外側面に付着されて光を偏光する二枚の偏光板で構成される。電場を印加しない状態で液晶分子は二つの基板に対して垂直に配向されており、電場を印加すると二つの基板の間に満たされた液晶分子が基板に平行に一定のピッチ(pitc-h)を有して螺旋状にもつれるようになる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】VATN液晶表示装置の場合、電界が印加されない状態で液晶分子が基板に対して垂直に配向されていて、直交する偏光板を使用する場合、電界が印加されない状態で完全に光を遮断することができる。つまり、ノーマリーブラックモードでオフ(off)状態の輝度が非常に低いので従来の捩じれネマチック液晶表示装置に比べて高い対比度を得ることができる。しかし、電界が印加された状態、特に階調電圧が印加された状態では通常の捩じれネマチックモードと同様に液晶表示装置を見る方向によって光の遅延(retardation)に大きな差が生じて視野角が狭いという問題点がある。

【0005】このような問題点を解決するために電極をパターニングし、これによるフリンジフィールド(fringefield)を用いて多重領域を形成する方法が多様に提示された。米国特許第5,309,264号でLienは共通電極にX字型の開口部を形成する方法を提示し、Histake等は米国特許5,434,690号で上下基板に形成されている電極に交互に開口30部を形成する方法を提示した。

【0006】しかし、前記のような方法を使用して分割配向を形成する場合、共通電極をパターニングするために別途のマスクが必要であり、カラーフィルター上に保護膜がない構造ではカラーフィルターの顔料が液晶物質に影響を与えるのでカラーフィルター上に保護膜を形成しなければならず、パターニングされた電極の端部で転傾が激しく発生する等の問題点が存在する。

【0007】本発明がなそうとする技術的課題は、上記のような問題点を有しない広視野角液晶表示装置を提供 40 することにある。

【0008】本発明がなそうとする他の技術的課題は、広視野角液晶表示装置の画質を改善することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決するために本発明では、共通電極が陥没パターンを有するように形成する。

【0010】具体的には、第1基板の上に多数の画素電極が形成されており、第1基板と対向している第2基板の上に画素電極と対応する部分に位置するように形成さ 50

れた陥没パターンを有する共通電極が形成されている。 この時、陥没パターンの側壁は第1基板と30°から1 20°の間の角をなす。

【0011】また、第1基板の上に維持容量電極と多数の画素電極が形成されている。第1基板と対向している第2基板の上に画素電極と対応する部分に位置する陥没パターンを有する共通電極が形成されている。この時、第1基板を上から見ると画素電極が維持容量電極を少なくとも一定の部分で完全に覆っている。

10 [0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を参考にして本発明の 実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の構 造について説明する。

【0013】図1は、本発明の第1実施例による液晶表示装置の断面図である。

【0014】液晶表示装置は下部基板10と、これと対向している上部基板60及び下部基板10と上部基板60との間に注入されて基板10、60に垂直に配向されている液晶物質90からなる。

【0015】ガラスなどの透明な絶縁物質からなる下部 基板10の上にはITO (indi-um tin ox ide) &IZO (indium zinc oxid e) などの透明な導電物質からなり、開口パターン51 を有している画素電極50が形成されており、各画素電 極50はスイッチング素子11に連結されて画像信号電 圧の印加を受ける。この時、スイッチング素子11とし ては薄膜トランジスタが用いられるのが通常であり、薄 膜トランジスタは走査信号を伝達するゲート線(図示せ ず)と画像信号を伝達するデータ線(図示せず)に各々 連結されて走査信号によって画素電極50をオン(o n) オフ (o f f) する。また、下部基板 1 0 の下面に は下部偏光板14が付着されている。ここで、画素電極 50は反射型液晶表示装置である場合には、不透明な物 質からなることもあり、この場合には下部偏光板14も 不必要となる。

【0016】同様に、ガラスなどの透明な絶縁物質からなる上部基板60の下面に光漏れを防止するためのブラックマトリックス70と赤、緑、青のカラーフィルター61及びITOまたはIZOなどの透明な導電物質からなっている共通電極80が形成されている。

【0017】この時、カラーフィルター61には陥没部が形成されている。従って、カラーフィルター61の上に形成されている共通電極80は、カラーフィルター61の陥没部に沿って、陥没パターン81を有する。

【0018】ブラックマトリックス70は、画素領域の周囲部だけでなく、共通電極80の陥没パターン81の上部にも形成されている。これは後述するように陥没パターン81によって発生する光漏れを防止するためである。

【0019】一方、共通電極80は、陥没パターン81

30

5

の部分がブラックマトリックス70と接触している。ブラックマトリックス70は有機物質で形成することがあるが、クロムなどの導電性物質で形成するのが一般的である。ブラックマトリックス70を導電性物質で形成する場合には、ブラックマトリックス70も共通電極80からの信号を伝達する導電通路として作用して、共通電極抵抗を減少させることができる。

【0020】このような構造を通じて広視野角を得ることができる理由を説明する。

【0021】液晶表示装置に電界を印加しない状態では、液晶分子90は二つの基板10、60に垂直に配列された状態を維持するので共通電極に陥没パターンがない時と同一なブラック状態を示す。

【0022】電界を印加すると、図1に示されているように、大部分の所では基板10、60に垂直な電場が形成される。一方、カラーフィルター61が除去されて形成された陥没部近くでは共通電極80がカラーフィルターのパターンに沿って屈曲形態に形成される。従って、二つの基板の間の等電位面は二つの基板10、60に対して平行に形成されず共通電極80の形状によって曲がる。結局、電場も基板10、60に対して垂直に形成されず多少傾いた方向に形成される。

【0023】液晶が陰の誘電率異方性を有するので、液晶分子の配列方向は、電場の方向と垂直になろうとする。従って、陥没パターン81近くの液晶分子の長軸は二つの基板10、60表面に対して傾いたままで捩じれる。このようになると、陥没パターン81の中心線を基準に両側で液晶分子の傾く方向が反対になる二つの領域が生じ、二つの領域の光学的特性が互いに補償されて視野角が広くなる。

【0024】図1のように、カラーフィルター61の一部を除去して共通電極80に陥没パターン81を形成すると、ラビングなどの方法に比べて簡単な工程で分割配向を形成することができるだけでなく、液晶分子の配列が他の領域を非常に微細に調整したり多様な形状に作ることができるという利点がある。

【0025】一方、カラーフィルター61の厚さのうちの一部だけを除去して、一部は残っている状態に形成することもできる。

【0026】次に、本発明の実施例による液晶表示装置 40 用カラーフィルター基板を製造する方法について説明する。

【0027】まず、基板の上にクロムなどの金属や黒色 レジストを一層形成してパターニングし、ブラックマト リックスを形成する。

【0028】次に、赤、緑、青のうち一色のレジストを 塗布してパターニングして溝を有するカラーフィルター を形成し、順次に他の2色のレジストを塗布してパター ニングする過程を経て三色のカラーフィルターを完成す る。 【0029】または、赤、緑、青のレジストを順次に塗布してパターニングしカラーフィルターを形成した後、一度に三カラーフィルターに溝を形成することもできる。

6

【0030】最後に、ブラックマトリックスとカラーフィルターの上にITOなどの透明導電物質を蒸着して共通電極を形成する。共通電極を形成する時にはカラーフィルターに形成された溝の近くで段差によって共通電極が切れる恐れがあるので薄く2度にわけて蒸着するのが好ましい。

【0031】次に、陥没パターンの形態と液晶表示装置の画質との関係を見てみる。

【0032】図2と図3は、本発明の第1実施例による 液晶表示装置の断面図であって、カラーフィルターに形 成された陥没パターンの側壁が基板に対して各々90° をなす場合と45°をなす場合の等電位面と光透過率曲 線を示す図面である。

【0033】図2の場合には、共通電極80の陥没パターン下部と画素電極50の開口部51上部でだけ等電位面が激しい屈曲を有する。したがって、光の透過率も陥役パターンと開口部がある部分でだけ急激に変化する。従って、陥没パターンが形成されている部分だけ遮るとテクスチャー(texture)は現れない。しかし、図3の場合には、共通電極80の陥没パターンの下部と画素電極50の開口部51上部だけでなく陥没パターンの周辺でも等電位面が激しい屈曲を有する。光の透過率も、陥没パターンと開口部がある部分はもちろん、陥没パターン周辺部でも急激に変化する。従って、陥没パターン周辺部下にテクスチャーが現れるようになる。

【0034】以上で類推できるように、陥没パターンの側壁が基板となす角が小さければ小さいほどテクスチャーは陥没パターン周辺部に広く広がる。従って、陥没パターンの側壁が基板となす角は大きいほど良い。ここで、陥没パターンの側壁と基板とがなす角は、カラーフィルター61が詰められた側から測った角である。この角は90°を超えることもある。しかし、この角が120°以上になるとITOなどの物質で形成される共通電極80が陥没パターン部分で切断される可能性が高い。

【0035】図3では、陥没パターンの側壁と基板との間の角が45°である場合にも、テクスチャーTが陥没パターン周辺に現れているが、表示品質を大きく落とす程ではない。また、陥没パターンの幅や画素電極の開口部幅などを変化させることによってある程度調節が可能である。従って、側壁と基板の間の角度の下限は30°程度である。

【0036】次に、本発明の第2実施例による液晶表示 装置について説明する。

【0037】図4は本発明の第2実施例による液晶表示 装置の平面図であり、図5は図4のIV-IV^{*}線による断 50 面図であり、図6は本発明の効果を説明するための断面

30

図であり、図5と対比される図面である。

【0038】下部の絶縁基板10上に横方向にゲート線20が形成されている。ゲート線20にはゲート電極21が突起の形態に形成されている。絶縁基板10上にはゲート線20と並んで二つの共通電極線22,25が形成されている。二つの共通電極線22,25は縦方向に形成されている二つの維持容量電極23、24によって互いに連結されている。この時、共通電極線22,25の数は3つ以上であることもあり、または単一線で形成することもある。ゲート線20、ゲート電極21、共通電極線22,25及び維持容量電極23、24はアルミニウムまたはクロムなどの金属で形成する。この時、これらは単一層に形成することもあり、クロム層とアルシームをは単一層に形成することもあり、クロム層とアルシームをは単一層に形成することもあり、クロム層とアルシームの経験な金属を使用してゲート配線と共通配線を形成することができる。他にも多様な金属を使用してゲート配線と共通配線を形成することができる。

【0039】ゲート線20と共通電極線22,25及び 維持容量電極23、24の上には窒化ケイ素(SiN x)等からなるゲート絶縁膜31が形成されている。

【0040】ゲート絶縁膜31の上には、縦方向に、デ 20 ータ線40が形成されている。データ線40には分枝としてソース電極41が形成されており、ソース電極41 に隣接してドレーン電極42が形成されている。データ線40、ソース電極41及びドレーン電極42もゲート配線と同様にクロムとアルミニウムなどの物質で形成する。また、単一層または多重層に形成することができる。

【0041】ソース電極41とドレーン電極42の下部には、薄膜トランジスタのチャンネル部として用いられる半導体層(図示せず)とソース及びドレーン電極41、42と半導体層の間の接触抵抗を減少させるための接触層(図示せず)が形成されている。半導体層は非晶質ケイ素を使用して形成するのが通常であり、接触層はn型不純物として高濃度にドーピングされた非晶質ケイ素を使用して形成する。

【0042】データ線40などの上には、窒化ケイ素などの無機絶縁物や樹脂などの有機絶縁物からなる保護膜32が形成されている。保護膜32にはドレーン電極42を露出させる接触孔(図示せず)が形成されている。

【0043】保護膜32の上には開口パターン51を有する画素電極50が形成されている。画素電極50はI TOや120などのような透明導電体やアルミニウム

(A1) のような光反射特性に優れた不透明導電体を使用して形成する。画素電極50に形成されている開口パターン51は、画素電極50を上下に二分する位置に横方向に形成されている横開口部と、二分された画素電極50の上下部分に各々斜線方向に形成されている斜線開口部とを含む。この時、上下の斜線開口部は互いに垂直をなしている。これはフリンジフィールドの方向を4方向に均一に分散させるためである。つまり、開口パター50

ン51と後述する陥没パターン81によって分割される 小領域内で液晶の傾く方向が、四方に分散するようにす るためである。このとき、上下斜線開口部がなす角は、 90度(垂直)付近で多少変動することがある。即ち、 上下斜線開口部がなす角は、85度~95度の間で変動 することがある。

【0044】この時、維持容量電極23、24は液晶表示装置を上から見る時、A、B、C及びD部分で画素電極50によって完全に覆われるように形成されている。

【0045】上部の絶縁基板60には光が漏れることを防止するためのブラックマトリックス70が形成されている。ブラックマトリックス70の上には陥没部を有する赤、緑、青のカラーフィルター61が形成されている。カラーフィルター61の上には、カラーフィルター61の陥没パターン81を有する共通電極80が形成されている。この時、陥没パターン81はカラーフィルター61の陥没部によって形成されたものである。共通電極80はITOまたはIZOなどの透明な導電体で形成する。

【0046】共通電極80の陥没パターン81は画素電極50の斜線開口部を間に介在しており、これと並んで斜線部と画素電極50の辺と重なっている屈折部を含んでいる。この時、屈折部は縦方向屈折部と横方向屈折部とに分類される。このうち縦方向屈折部と重なる画素電極50の部分(A、B、C、D)では画素電極50がその下部の維持容量電極23、24を完全に覆っている。このようにするとテクスチャー線が現れるのを防止することができる。

【0047】次に、図5と図6を参考として本発明による液晶表示装置でテクスチャー発生が防止できる理由を説明する。

【0048】まず、図6を参考として液晶表示装置でテ クスチャーが発生する原因を見てみる。

【0049】図6には、共通電極800と画素電極500との間に電界が印加された時の、電気力線の形状及びこれによって配列された液晶分子が図示されている。図6に示されたように、維持容量電極230、240と画素電極の辺りの間に強い電界が形成される。このような電界は画素領域周辺部の電界に影響を与える。このような影響は共通電極800の陥没パターン81が形成されている部分(A、B、C、D)で特に大きく現れる。このために画素領域周辺部に画素領域の中央部とは反対方向に傾いたフリンジフィールドが形成される。従って、画素領域の周辺部と中央部との間の部分(T)で液晶分子の配列方向が反転する。この部分(T)が画面でテクスチャーとして現れる。

【0050】では、図5を参考として本発明による液晶 表示装置におけるテクスチャー発生が防止できる理由を 説明する。

【0051】図5では、画素電極50が維持容量電極2

3、24を完全に覆っている。従って、画素電極50と維持容量電極23、24との間に形成する電気力線は大部分画素電極50の下側表面と連結する。その結果、維持容量電極23、24との間で形成される電界は液晶分子には影響を与えない。維持容量電極23、24に影響を受けないフリンジフィールドは画素領域内では一定の方向性を維持し、画素領域を抜け出した地点(ブラックマトリックスに遮られた部分)に至って傾く方向が変化する。結局液晶分子の配列方向が反転する部分(T)も画素領域を抜け出した部分で現れる。この部分はブラックマトリックスによって遮られるので画面上にはテクスチャーが現れない。

【0052】本発明の第3実施例による液晶表示装置について説明する。

【0053】図7は、本発明の第3実施例による液晶表示装置の平面図である。

【0054】第3実施例による液晶表示装置も配線及び 薄膜トランジスタなど基本的な構造は第2実施例のそれ と同一である。ただし、画素電極50の開口パターン5 1と共通電極の陥没パターン81の形状と維持容量電極 20 24及び共通電極線25の平面積形状が異なる。

【0055】開口パターン51は、横方向に形成された 横開口部と縦方向に形成された縦開口部とを含む。陥没 パターン81は、画素電極50辺りと重なるように形成 された周囲部と二つの横開口部の間に形成されている横 部を含む。

【0056】開口パターン51と陥没パターン81は重複して画素電極50を多数の小領域に分割する。各小領域は最も長い二つの辺が互いに平行な多角形をなす。これは液晶分子の応答時間を短くするためである。つまり、開口パターン51と陥没パターン81によって形成されるフリンジフィールド(fringe field)によって液晶分子が配列される方向が液晶分子相互間に平行する状態になるようにするものである。このようにすると1段階動作だけで液晶分子の動作が完了するために応答時間が短縮する。

【0057】前記の第2実施例による液晶表示装置においても開口パターン51と陥没パターンによって分割された小領域は最も長い二つの辺が平行な多角形をなしている。

【0058】共通電極線25は、横方向にのびている単一線で形成されているが、複数に形成され得る。共通電極線25は陥没パターン81の横部と重なっている。維

持容量電極24は、画素電極50の左右辺と並んで形成されていて、画素電極50によって覆われている。これは第2実施例と同様にテクスチャーの発生を防止するためである。

10

【0059】最後に、本発明の第4実施例による液晶表示装置について、図8を参照して説明する。

【0060】第4実施例による液晶表示装置も、画素電極50の開口パターン51と共通電極の陥没パターン81の模様と維持容量電極24及び共通電極線25の平面形状だけが第2及び第3実施例と異なる。

【0061】第4実施例での開口パターン51はX字型数個で形成されている。陥没パターン81は周囲部と横部を含んでおり、X字型開口パターン51各々を孤立させる形態で形成されている。

【0062】共通電極線25は横方向にのびている単一線で形成されているが、複数で形成され得る。共通電極線線25は陥没パターン81の横部のうちの一つと重なっている。維持容量電極24は、画素電極50によって覆われている。

[0063]

【発明の効果】本発明の実施例のように、カラーフィルターに溝を形成して分割配向液晶表示装置を形成すると、単純な工程で液晶表示装置の視野角をひろめることができ、応答速度が速くて優れた画質の液晶表示装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による液晶表示装置の断面 図である。

30 【図2】本発明の第1実施例における等電位面と光透過 率曲線(90°)。

【図3】本発明の第1実施例における等電位面と光透過率曲線 (45°)。

【図4】本発明の第2実施例による液晶表示装置の平面 図である。

【図5】図4のIV-IV´線による断面図である。

【図6】本発明の効果を説明するための断面図であって、図5に対応する図面である。

【図7】本発明の第3実施例による液晶表示装置の平面 40 図である。

【図8】本発明の第4実施例による液晶表示装置の平面 図である。

